

Транзисторы КТ683

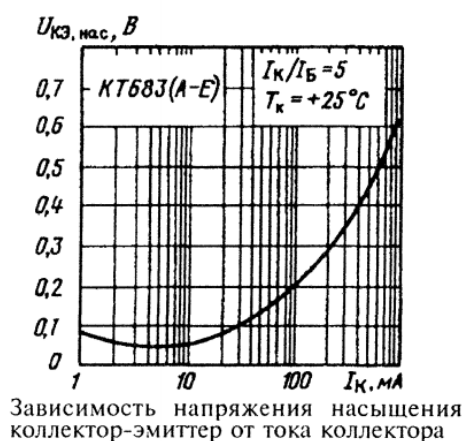
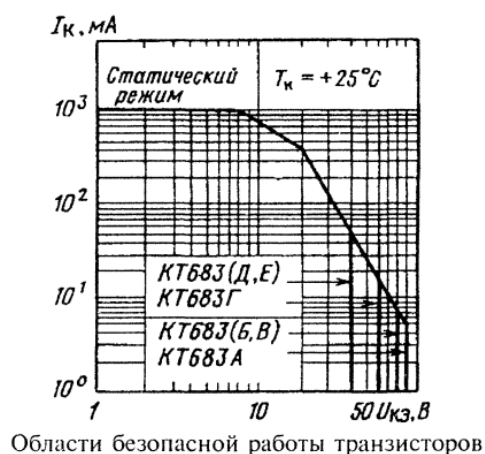
кремниевые планарные структуры n-p-n универсальные. Предназначены для применения в усилителях и переключающих устройствах.

Выпускаются в пластмассовом корпусе с жесткими выводами.

Масса транзистора не более 1 г.

Технические характеристики транзисторов КТ683

Параметры	КТ683А	КТ683Б	КТ683В	КТ683Г	КТ683Д	КТ683Е
Максимально допустимое напряжение коллектор-база, В	150	120	120	100	60	60
Максимально допустимое напряжение коллектор-эмиттер, В	150	120	120	100	60	60
Максимально допустимый постоянный ток коллектора, мА	1000 (2000)	1000 (2000)	1000 (2000)	1000 (2000)	1000 (2000)	1000 (2000)
Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора с теплоотводом, Вт	1.2(8)	1.2(8)	1.2(8)	1.2(8)	1.2(8)	1.2(8)
Статический коэффициент передачи тока биполярного транзистора в схеме с общим эмиттером	40-120	80-240	40-120	40-120	80-240	160-480
Обратный ток коллектора, мкА	≤ 1	≤ 1	≤ 1	≤ 1	≤ 1	≤ 1
Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером, МГц	≥ 50	≥ 50	≥ 50	≥ 50	≥ 50	≥ 50
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер, В	<0.45	<0.45	<0.45	<0.45	<0.45	<0.45



Перед заказом проконсультируйтесь с техническим специалистом



8-800-100-90-86



info@ippart.com



ip-electronics